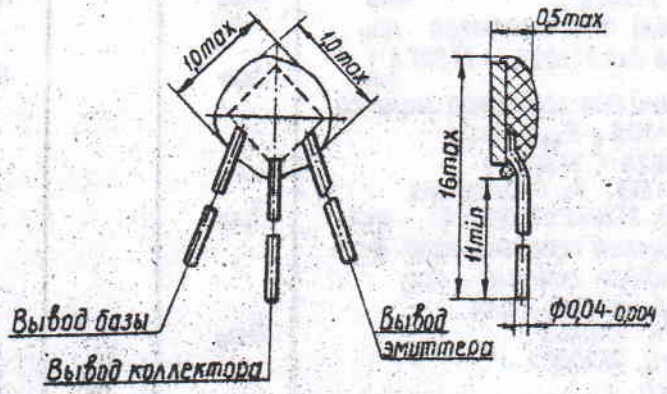
Этикетка

Транзисторы типов:
2Т202А-1, 2Т202Б-1, 2Т202В-1,
2Т202Г-1, 2Т202Д-1
соответствуют техническим условиям 3.365.034ТУ



Масса транзистора не более 10 мг.

Содержание драгметаллов в 1000 шт. транзисторов

золото 0,8829 мг

палладий 0,0326

Допускается натекание компаунда на выводы не более 0,3 мм от края кристалла.

conector.by

Основные электрические параметры при $t_{окр.} = 25°C \pm 10°C$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
1. Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 30$ В для 2Т202В-1, 2Т202Г-1 при $U_{кб} = 15$ В для 2Т202А-1, 2Т202Б-1 2Т202Д-1, мкА	$I_{кбо}$		0,1
2. Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 10$ В для 2Т202А-1 ÷ 2Т202Д-1 мкА	$I_{эбо}$		0,1
3. Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{кэ} = 30$ В и $R_{бэ} \leq 10$ кОм для 2Т202В-1, 2Т202Г-1 при $U_{кэ} = 15$ В, $R_{бэ} \leq 10$ кОм для 2Т202А-1, 2Т202Б-1, 2Т202Д-1, мкА	$I_{кэк}$		1
4. Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{кб} = 5$ В, $I_э = 1$ мА для 2Т202А-1, 2Т202В-1 2Т202Б-1, 2Т202Г-1 2Т202Д-1	$h_{21э}$	15 40 100	70 160 300
5. Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_к = 10$ мА, $I_б = 1$ мА для 2Т202А-1 ÷ 2Т202Д-1, В	$U_{бэнас}$		1
6. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_к = 10$ мА, $I_б = 1$ мА для 2Т202А-1 ÷ 2Т202Д-1, В	$U_{кэнас}$		0,5

Штамп ОТК ОТК 11 3

Штамп представителя заказчика 2

ОТК 7.08.82 2857 13.10.83

conector.by